

Title	アルフェロフ教授のノーベル物理学賞受賞について
Author(s)	森, 伸也
Citation	大阪大学低温センターだより. 113 P.22-P.22
Issue Date	2001-01
Text Version	publisher
URL	http://hdl.handle.net/11094/4273
DOI	
rights	
Note	

Osaka University Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/>

アルフェロフ教授の ノーベル物理学賞受賞について

工学研究科 森 伸也 (内線 7766)

E-mail:mori@ele.eng.osaka-u.ac.jp

低温センターだよりの第112号(2000年10月号)の談話室に「第25回半導体物理学国際会議について」という話を書きましたが、その原稿は、国際会議の終了した直後に書き上げたものでした。原稿を提出した後、1ヶ月もたたないうちに大変嬉しいニュースが飛び込んできましたので、補足させていただきます。それは、国際会議の組織委員会が企画した特別シンポジウムにて「ヘテロ接合レーザー：新しい物理と新しい技術の発展」という講演をされたロシアのヨッフエ研究所のアルフェロフ氏(Zhores I. Alferov)が2000年度のノーベル物理学賞を受賞されたということです。アルフェロフ氏は高速光エレクトロニクスに不可欠なヘテロ構造半導体レーザーを実現した功績で受賞されました。他に、集積回路を発明したキルビー氏(Jack S Kilby)と、ヘテロ構造半導体レーザーを発案したクレーマー氏(Herbert Kroemer)が2000年度のノーベル物理学賞の受賞者です。

蛇足ですが、半導体関係のノーベル物理学賞としましては、1998年の分数量子ホール効果の発見に対して贈られたものが記憶に新しいところですが、その受賞者の方々も、半導体物理学国際会議で特別講演をおこなった直後に受賞されたそうです。